





	<p>SI2307BDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2307BDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2307BDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28158 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2307BDS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28158 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2.5A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	78 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2307BDS-T1-GE3-ND

SI2307BDS-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI2307BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2307BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2307BDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2307BDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307-TP Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p>SI2307BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3</p>
 <p>SI2307CDS A7SHB Original SOT-23</p>	 <p>SI2307BDS-T1-E3 VISHAY SI2307BDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2307CDS VISHAY SI2307CDS VISHAY</p>	 <p>SI2307BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3
 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB
 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1	 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3
 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3	 SI2306DS	 SI2306DS-T1	 SI2306DS-T1-E3
 SI2306DS-T1-GE3	 SI2306WCA	 SI2307BDS	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-E3
 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-GE3
 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307DS	 SI2307DS-T1	 SI2307DS-T1-E3	 SI2307DS-T1-GE3
 SI2307DS-T7-E3	 SI2308BDS	 SI2308BDS-T1-E3	 SI2308BDS-T1-E3	 SI2308BDS-T1-GE3
 SI2308BDS-T1-GE3	 SI2308DS	 SI2308DS-T1	 SI2308DS-T1-E3	 SI2308DS-T1-E3
 SI2308DS-T1-GE3	 SI2309BDS-T1-E3	 SI2309BDS-T1-GE3	 SI2309CDS-T1-GE3	 SI2309CDS-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

